МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №5

по теме: «Исследование биполярных транзисторов. Часть 1»

Работу выполнил: студент группы ИУ7-33Б Артемьев Илья

Работу проверил: Оглоблин Д. И.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКУМА:

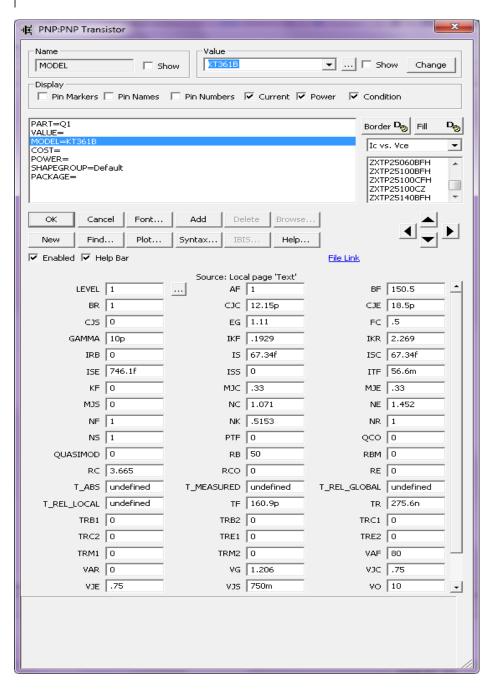
Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах.

ЭКСПЕРИМЕНТ 1

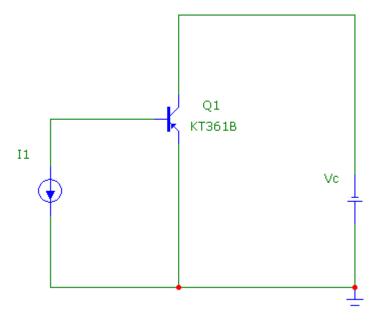
Снятие ВАХ биполярного транзистора

Включаем транзистор во вкладку Text.

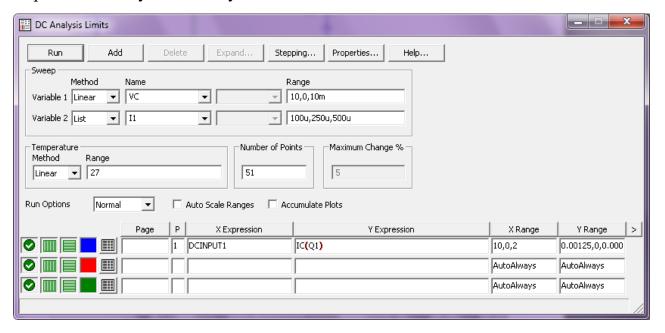
.MODEL KT361b PNP (BF=150.5 CJC=12.15p CJE=18.5p FC=.5 IKF=.1929 IKR=2.269 + IS=67.34f ISC=67.34f ISE=746.1f ITF=56.6m MJC=.33 MJE=.33 NC=1.071 NE=1.452 + NK=.5153 RB=50 RC=3.665 TF=160.9p TR=275.6n VAF=80 VJC=.75 VJE=.75 VTF=40 + XTB=1.5 XTF=.3203)

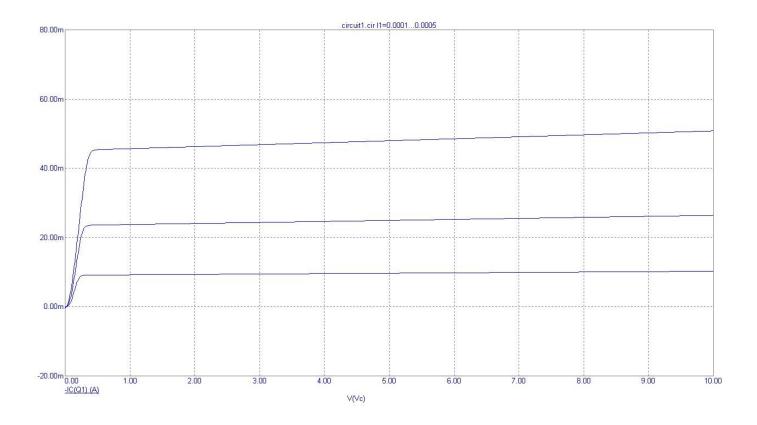


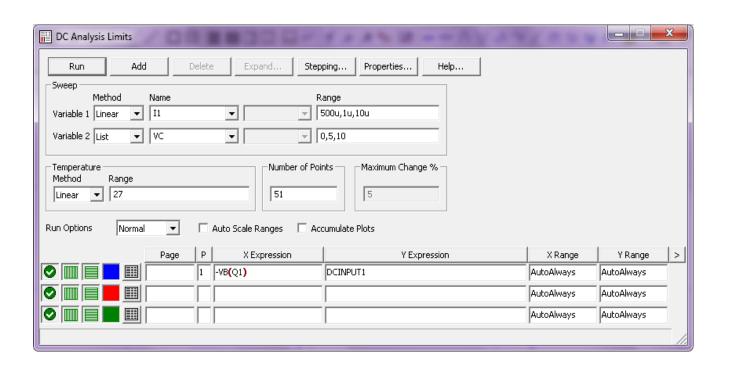
Строим схему.

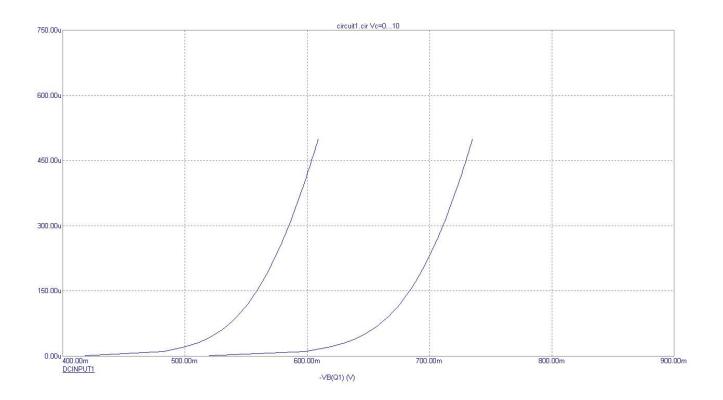


Строим выходную и входную ВАХ.

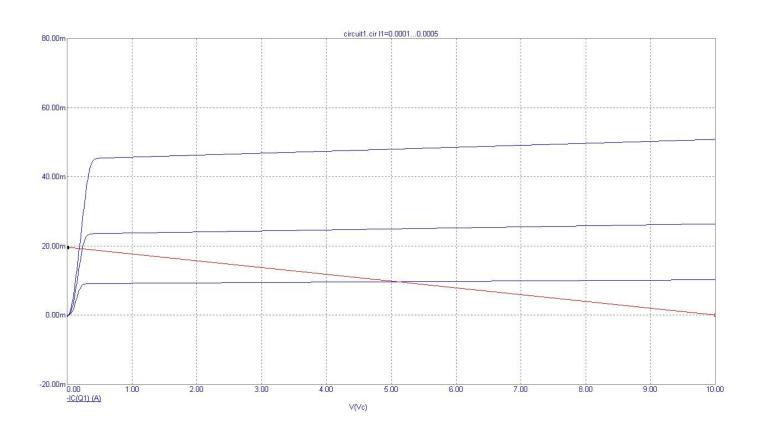


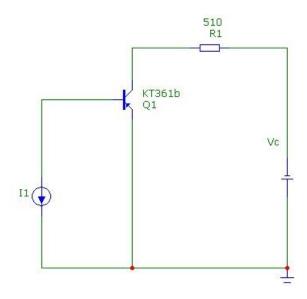


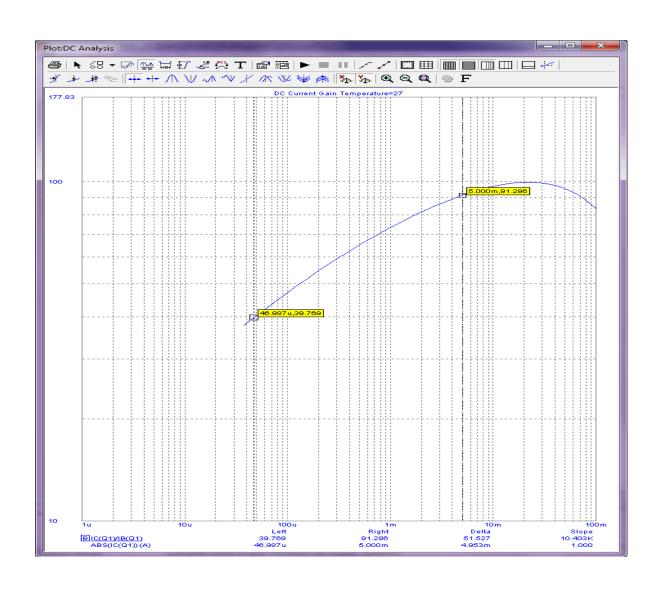


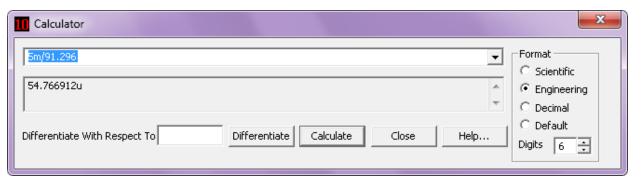


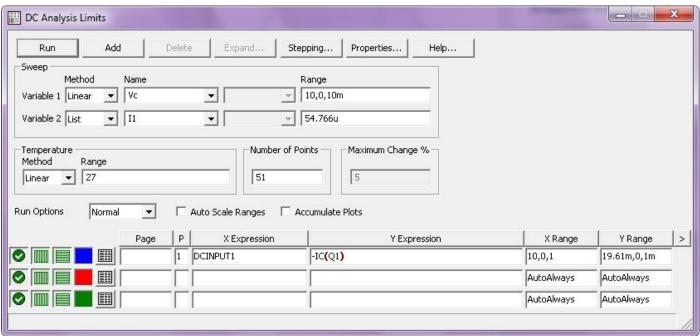
На выходной ВАХ в соответствии с моим нечетным вариантом (Rk=510 Om, Ek=10 B) построим нагрузочную прямую (I = U / R = 10 / 510 = 19.61mA)

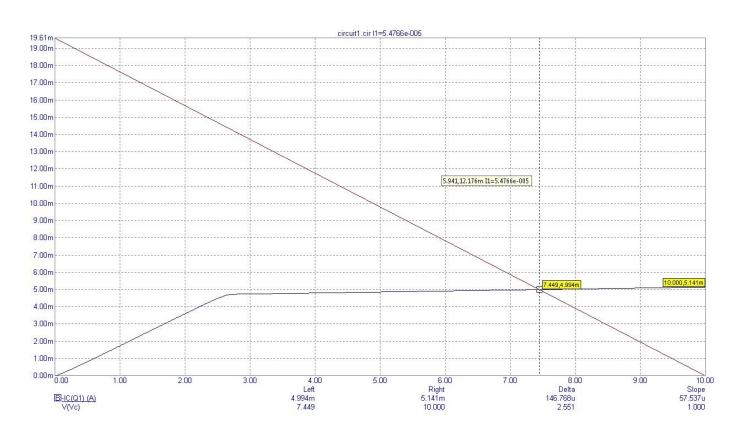


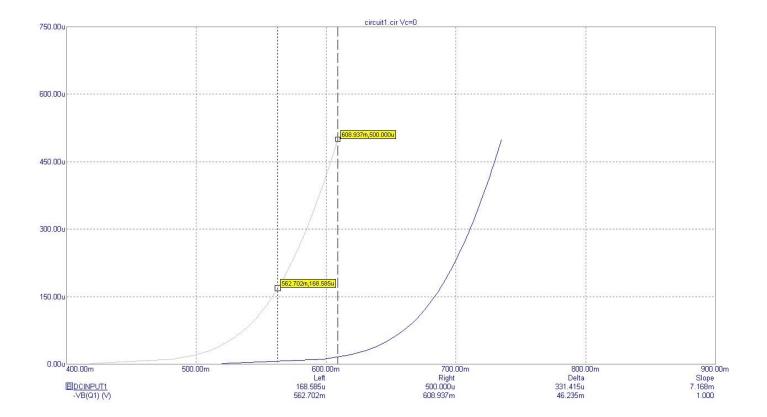












Ik = 168.585 uA

BF = 150.5

Ib = 168.585 uA / 150.5 = 1.1 uA

Ube = 562.702 mV

ЭКСПЕРИМЕНТ 2

Установка рабочей точки каскада усиления с общим эмиттером дополнительными элементами схемы

Рассчитываем величину сопротивления в цепи базы, а также сопротивление в цепи коллектора.

$$Uk = 5$$

$$Ek := 10$$

$$Ub := 0.75$$

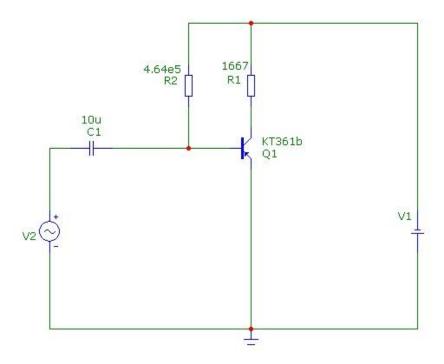
$$Ik := 3.10^{-3}$$

$$Ib:=\frac{Ik}{BF}=1.993\times 10^{-5}$$

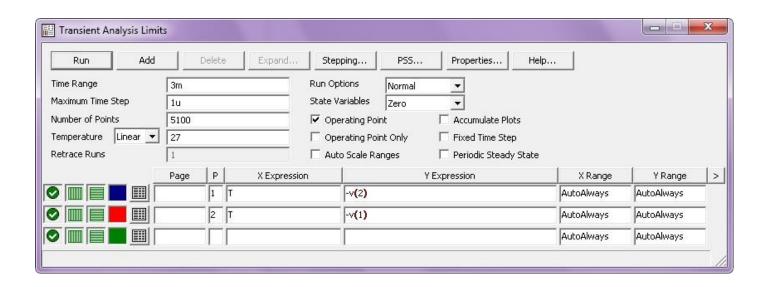
$$Rk := \frac{(Ek - Uk)}{Ik} = 1.667 \times 10^3$$

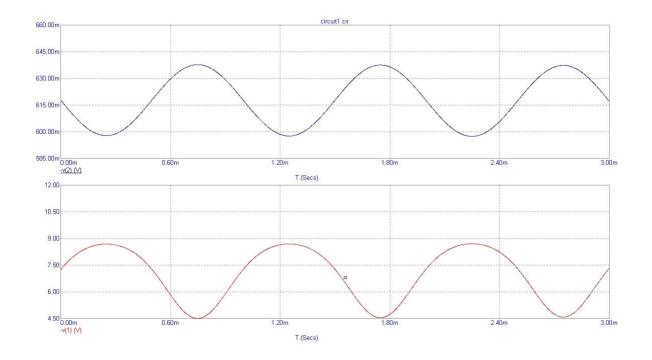
Rb :=
$$\frac{(Ek - Ub)}{Ib} = 4.64 \times 10^5$$

Отмечаем полученные значения на схеме.



Строим графики входного и усиленного сигналов.





Рассчитаем коэффициент усиления.

$$M(входной) = 637.728m - 597.629m = 40.099m$$

$$M($$
усиленный $) = 8.682 - 4.507 = 4.175$

$$K = M(усиленный) / M(входной) = 104.117$$

Добавляем делитель напряжения.

$$U\mathbf{k} := 5 \qquad E\mathbf{k} := 10 \qquad U\mathbf{b} := 0.75 \qquad I\mathbf{k} := 3 \cdot 10^{-3} \qquad BF := 150.5 \qquad U\mathbf{n} := 1$$

Ib :=
$$\frac{Ik}{BF}$$
 = 1.993 × 10⁻⁵

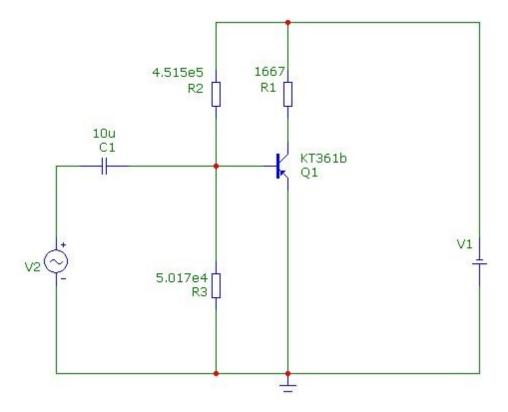
$$Rk := \frac{(Ek - Uk)}{Ik} = 1.667 \times 10^{3}$$

Rb :=
$$\frac{(Ek - Un)}{Ib} = 4.515 \times 10^5$$

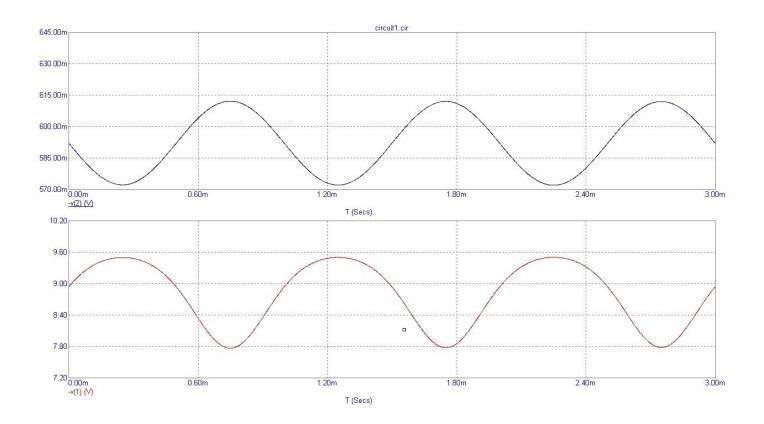
$$U\, d := E k$$

$$Rd := \frac{Ud}{10 \cdot Ib} = 5.017 \times 10^4$$

Отмечаем полученные значения на схеме.



Строим графики входного и усиленного сигналов.



Рассчитаем коэффициент усиления.

M(входной) = 612.133m - 572.088m = 40.045m

M(усиленный) = 9.500 - 7.767 = 1.733

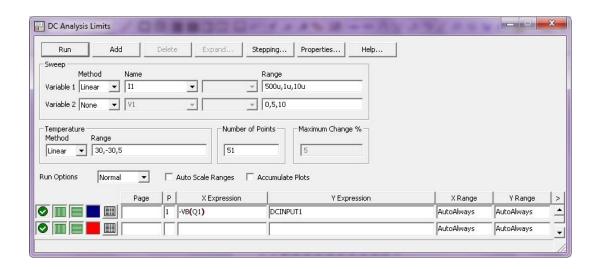
K = M(усиленный)/M(входной) = 43.276

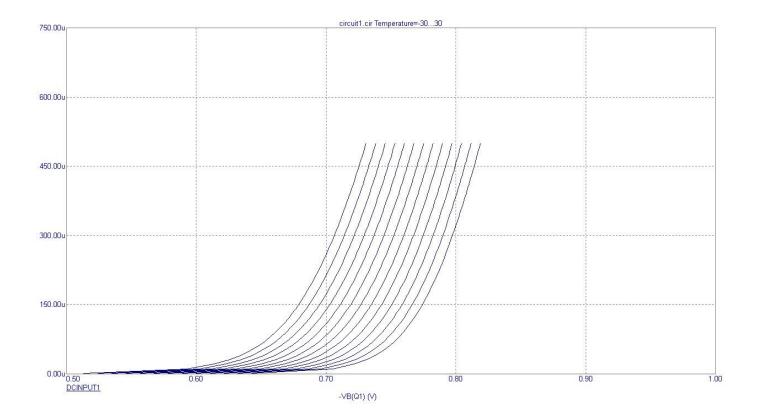
ЭКСПЕРИМЕНТ 3

Исследование влияния температуры на положение рабочей точки каскада с общим эмиттером биполярного транзистор

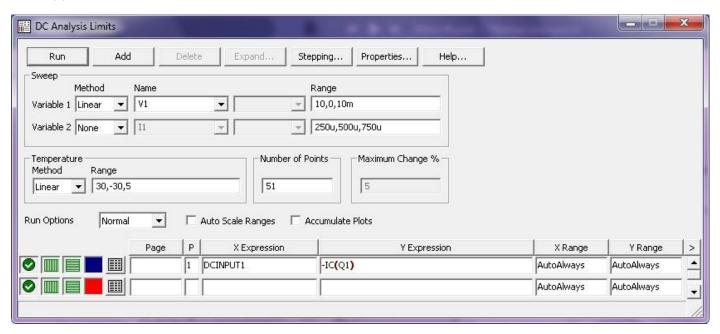
Исследуем влияние температур на входную и выходную ВАХ.

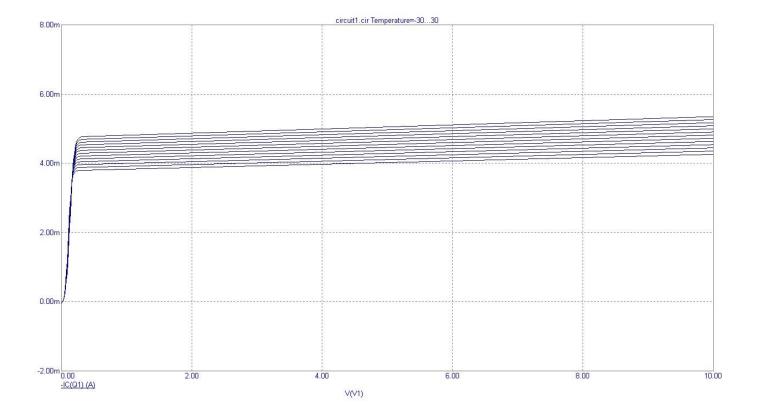
Входная ВАХ:





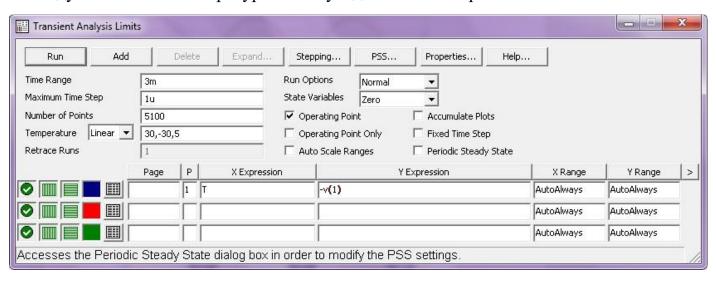
Выходная ВАХ:

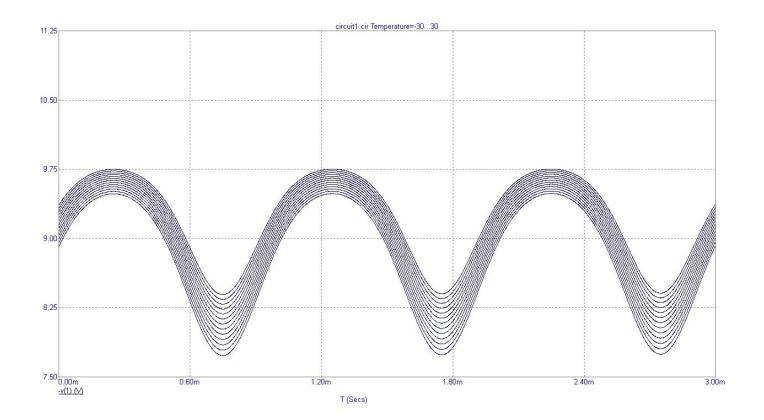




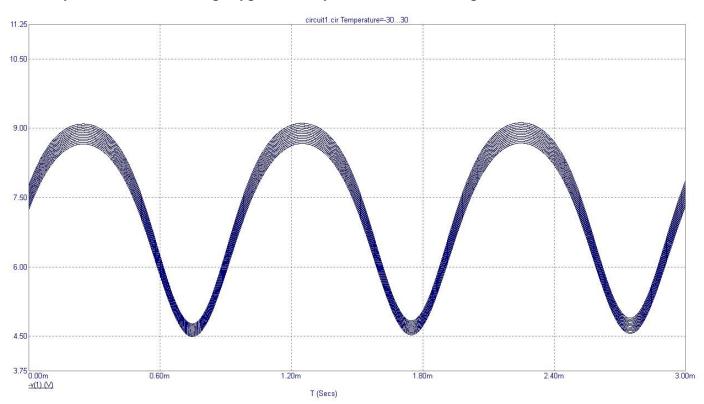
При повышении температуры увеличивается ток насыщения.

Исследуем влияние температур на схему с делителем напряжения.



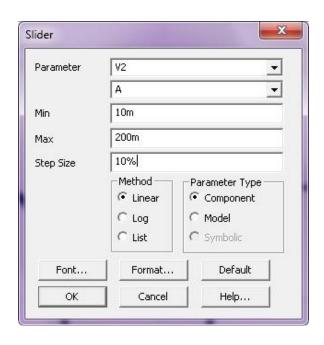


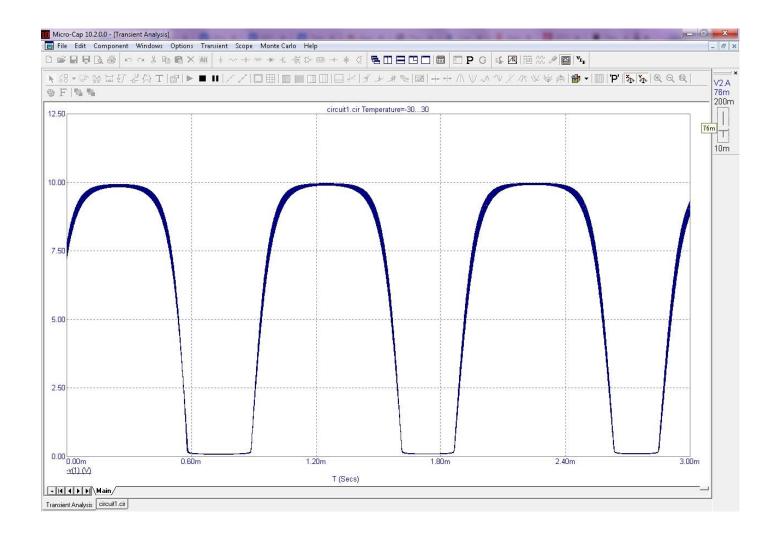
Исследуем влияние температур на схему без делителя напряжения.

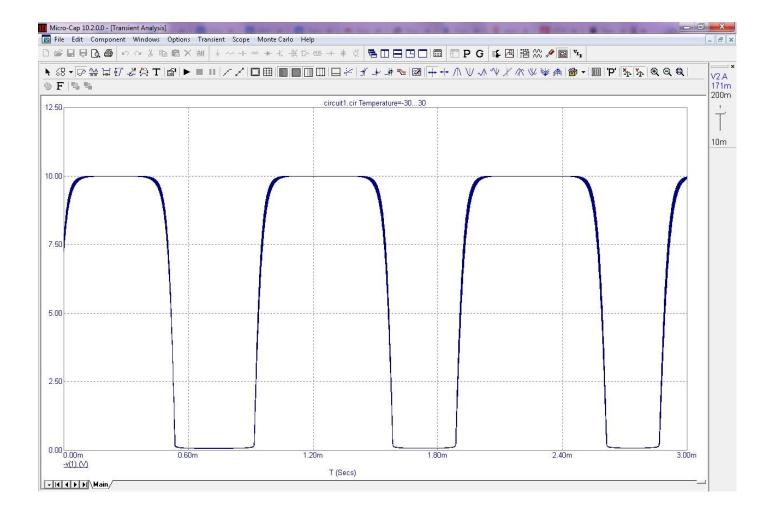


Исследуем влияние температур на каскад при изменении амплитуды входного сигнала с помощью слайдера.

Добавим слайдер.







Синусоида становится «квадратной», т.к. 10 Вольт – предел.